

薄膜実践セミナーⅡ

産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設(NPF)は、「薄膜実践セミナーⅡ」を、2016年11月15日(火)に産業技術総合研究所つくば中央にて開催いたします。前半は、スパッタ堆積法による機能性薄膜、後半は、2次元半導体材料等について取り上げます。オーサーズ・インタビューの時間を設けましたので、講師の方々に個別に質問をすることが可能です。

また、実習にはNPFの装置を使用してSrTiO₃誘電体薄膜形成・熱処理と、結晶性・電気特性評価などを盛り込み、機能性薄膜開発の基礎的なスキルを獲得していただけるように期待しています。産学官いずれのご所属の方にもご参加をお申込みいただけます。広くご参加をお待ちしています(*講演のみ、実習のみの参加申込も可能です)。

【講演】

【日時】平成28年11月15日(火) 12:55~

【場所】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟第6会議室

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

【参加費】無料

【定員】90名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内/申し込み】

<https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h28-3/index.html>

【講演プログラム】

12:55-13:00 「はじめに」 産業技術総合研究所 共用施設ステーション 多田哲也

13:00-13:40 「スパッタリングで作る機能性超格子薄膜とその応用

~相変化メモリからトポロジカル絶縁体まで~

産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 富永淳二

13:40-14:20 「機能性酸化物材料のスパッタリング」

株式会社アルバック超材料研究所 水野雄介

14:20-14:50 「スパッタリング法によるMgNbAlN圧電薄膜の開発」

産業技術総合研究所 製造技術研究部門 上原雅人

14:50-15:10 休憩(オーサーズインタビュー)

15:10-15:40 「プラズマCVDを用いたグラフェンの合成、評価、デバイス応用」

産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 沖川侑揮

15:40-16:10 「2次元層状半導体MoS₂のMOSFET応用」

産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 森 貴洋

16:10-16:25 「ナノプローバーによるHall効果測定」

産業技術総合研究所 ナノプロセッシング施設(NPF) 大塚照久

16:25-16:40 「原子層堆積(ALD)装置の利用事例

~Al₂O₃ゲート絶縁膜、TiO₂酸化物チャンネル、NbN超伝導膜~

産業技術総合研究所 ナノプロセッシング施設(NPF) 山崎将嗣

16:40-17:00 オーサーズインタビュー

【実習】

【日時】平成28年12月~平成29年2月の間の3日間

【場所】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟ナノプロセッシング施設(NPF)

【参加費】50,000円/人【定員】3名(同時に実施します)

案内・申し込み:<https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h28-3/article/index.html>

主催:

産総研TIA ナノプロセッシング施設(NPF)

共催:

ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会(TSC)

電子メール:tia-npf-school3@aist.go.jp

